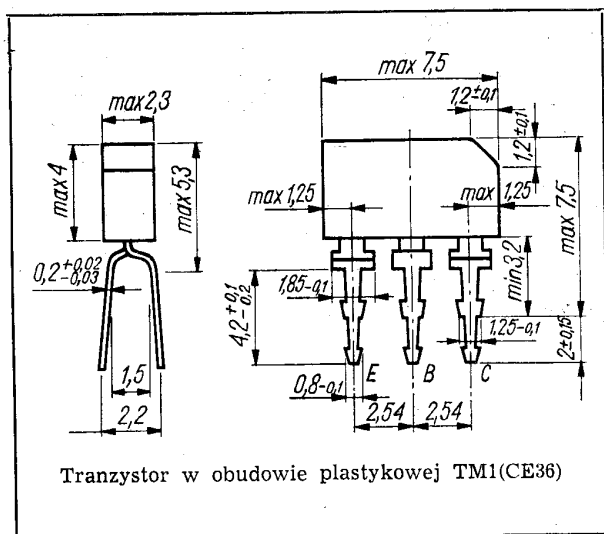


Tranzystor krzemowy epiplanarny małej mocy wielkiej częstotliwości.
Jest przeznaczony do stosowania w stopniach wyjściowych wzmacniaczy pośredniej częstotliwości wizji odborników telewizyjnych.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie kolektor-baza	U_{CB0}	40	V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE0}	25	V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	4	V
Prąd kolektora	I_C	25	mA
Prąd bazy	I_B	2	mA
Moc całkowita	P_{tot}	250	mW
Temperatura złącza	t_j	398 (125)	K (°C)
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	208...398 (-65...+125)	K (°C)

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)			
Prąd zerowy kolektor-baza			
przy $U_{CB0} = 10$ V	I_{CB0}	— 100	nA

16 Elementy półprzewodnikowe

SWW 1156-213

Napięcie przebicia

kolektor-baza

przy $I_E = 0$,

$U_{CB} = 10$ μ A

$U_{(BR)CB0}$	40	—	V
---------------	----	---	---

Napięcie przebicia

kolektor-emiter

przy $I_B = 0$,

$I_C = 7$ mA

$U_{(BR)CE0}$	25	—	V
---------------	----	---	---

Napięcie przebicia

emiter-baza

przy $I_C = 0$,

$I_E = 10$ μ A

$U_{(BR)EB0}$	4	—	V
---------------	---	---	---

Współczynnik wzmoc-

nienia prądowego

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V

h_{21E}	40	—	—
-----------	----	---	---

przy $I_C = 20$ mA,

$U_{CE} = 2$ V

h_{21E}	15	—	—
-----------	----	---	---

Napięcie stałe między

bazą a emiterem

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V

U_{BE}	—	0,9	V
----------	---	-----	---

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K

(25°C)

min. typ. maks.

Częstotliwość graniczna

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V,

$f = 100$ MHz

f_T	350	550	—	MHz
-------	-----	-----	---	-----

Pojemność sprzężenia

zwrotnego

przy $I_C = 1$ mA,

$U_{CE} = 10$ V, $f = 1$ MHz C_{12es}

	—	0,32	0,35	pF
--	---	------	------	----

Stała czasowa sprzę-

żenia zwrotnego

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V,

$f = 50$ MHz

$r_{bb}C_C$	—	—	10	ps
-------------	---	---	----	----

Konduktancja

wejściowa

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V,

$f = 35$ MHz

g_{11e}	—	4	—	mS
-----------	---	---	---	----

Admitancja przeno-

szenia w przód

przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V,

$f = 35$ MHz

$ Y_{21e} $	—	170	—	mS
-------------	---	-----	---	----

Konduktancja

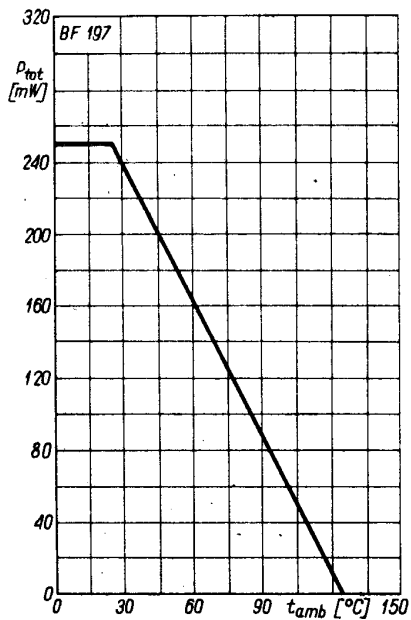
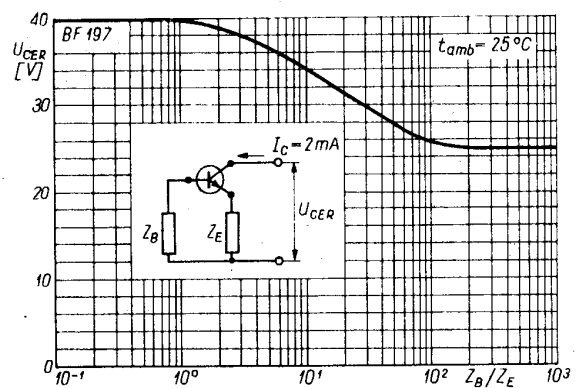
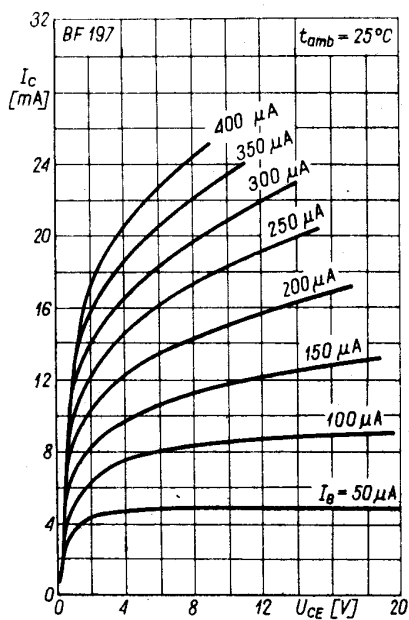
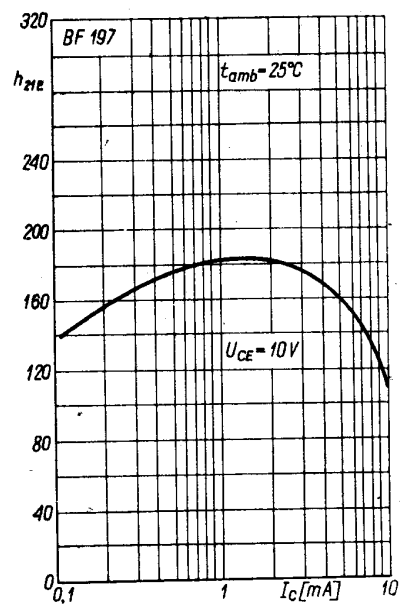
wyjściowa

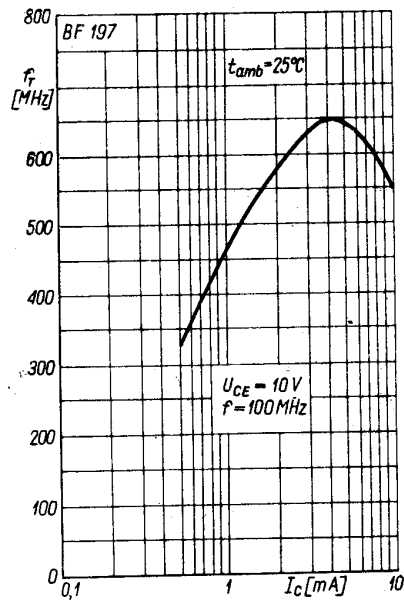
przy $I_C = 7$ mA,

$U_{CE} = 10$ V,

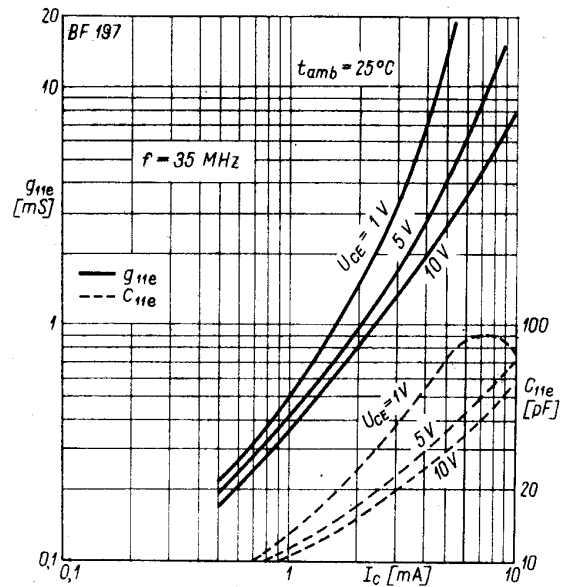
$f = 35$ MHz

g_{22e}	—	80	—	μ S
-----------	---	----	---	---------

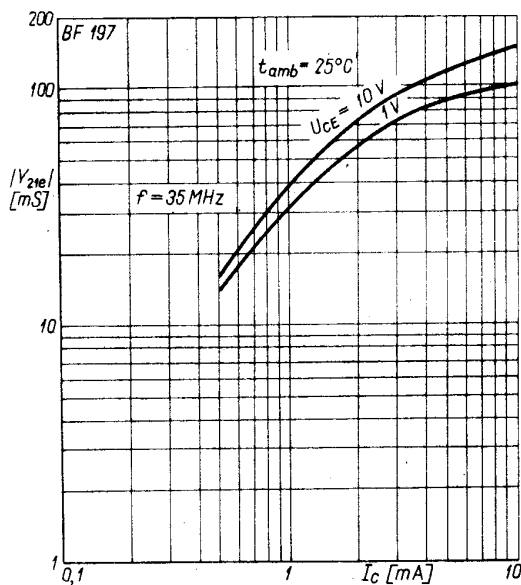
Zależność temperaturowa mocy strat $P_{tot} = f(t_{amb})$ Zależność napięcia kolektor-emiter od stosunku impedancji bazy i emitera $U_{CER} = f\left(\frac{Z_B}{Z_E}\right)$ Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametrZależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora $h_{21E} = f(I_C)$



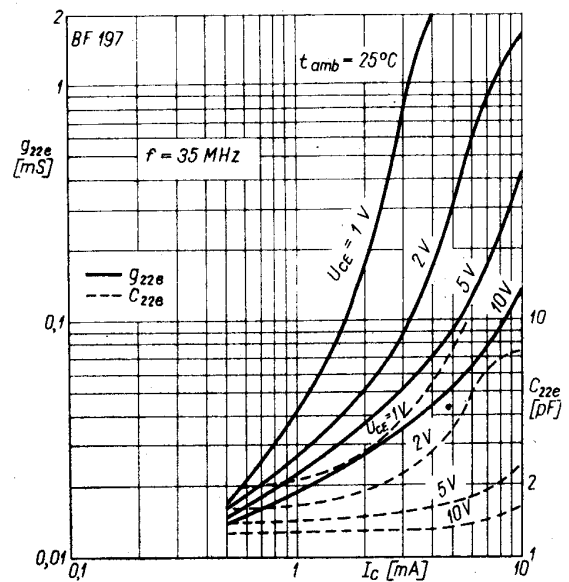
Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora $f_T = f(I_C)$



Zależność admitancji wejściowej od prądu kolektora $g_{11e}; C_{11e} = f(I_C)$



Zależność admitancji przejściowej w przód od prądu kolektora $|Y_{21e}|; \varphi_{21e} = f(I_C)$



Zależność admitancji wyjściowej od prądu kolektora $g_{22e}; C_{22e} = f(I_C)$